

■第35回応用物理学会 講演奨励賞受賞記念講演

開催日	時間	会場	中分類分科名、講演タイトルならびに講演者名(共著者含)
3/17 (月)	13:15 ~ 13:30	E14 ()	12.7 医用工学・バイオチップ カリウムイオンイメージセンサによる海馬スライス薬理効果解析 豊橋技科大 ¹ , EIIRIS ² , JST-CREST ³ ○河野顕輝 ^{1,2,3} , 櫻井孝司 ^{1,2,3} , 奥村弘一 ^{1,3} , 服部敏明 ^{1,3} , 石田 誠 ^{1,2,3} , 澤田和明 ^{1,2,3}
	14:00 ~ 14:15	F6 ()	3.1 光学基礎・光学新領域 モジュール型光ポンピング原子磁気センサによる MEG 計測 京大院工 ¹ , キヤノン ² ○鎌田啓吾 ¹ , 佐藤大地 ¹ , 伊藤陽介 ¹ , 夏川浩明 ¹ , 岡野久二 ¹ , 水谷夏彦 ² , 小林哲生 ¹
3/18 (火)	9:00 ~ 9:15	E2 ()	17.3 新機能探索・基礎物性評価 大面積単層 WSe ₂ 薄膜を用いた PN フォトダイオード 早大先進 ¹ , Academia Sinica ² , 東大院工 ³ , 理研 CEMS ⁴ , 早大材研 ⁵ ○蒲 江 ¹ , 清水 諒 ¹ , Chang-Hsiao Chen ² , 岩佐義宏 ^{3,4} , Lain-jong Li ² , 竹延大志 ^{1,5}
	9:00 ~ 9:15	E8 ()	6.3 酸化エレクトロニクス 周波数変調型原子間力顕微鏡による光触媒上の水和構造観察 東大物性研 ¹ , 神戸大理 ² ○川崎聖治 ¹ , 水光俊介 ² , 高橋竜太 ¹ , 大西 洋 ² , ミックリップマー ¹
	9:00 ~ 9:15	E14 ()	13.3 Si プロセス・配線・MEMS・集積化技術 プラズマメタマテリアルによる非冷却赤外線センサの新機能 - 非対称性による偏光検知 - 立命館大 ¹ , 三菱電機 ² , NMEMS 技術組合 ³ ○増田恭平 ^{1,2,3} , 小川新平 ^{1,2,3} , 高川陽輔 ¹ , 宮下晃一 ¹ , 木股雅章 ¹
	9:00 ~ 9:15	E16 ()	4.2 フォトニックナノ構造・現象 分子線エビタキシー法によるフォトニック結晶レーザ構造の作製 III - 空孔形状がレーザの特性に与える影響の検討 - 京大院工 ¹ , 京大白眉 ² ○西本昌哉 ¹ , 石崎賢司 ¹ , 前川亨平 ¹ , 梁 永 ¹ , 北村恭子 ^{1,2} , 野田 進 ¹
	9:00 ~ 9:15	F5 ()	7.2 電子顕微鏡, 評価, 測定, 分析 金属酸化物における酸素の電子状態マッピング 京大化研 ¹ , 物性研 ² ○治田充貴 ^{1,2} , 長井拓郎 ² , 倉嶋敬次 ² , 島川祐一 ¹ , 倉田博基 ¹ , 木本浩司 ²
	9:00 ~ 9:15	F6 ()	15.5 IV 族結晶, IV-IV 族混晶 AI 誘起層交換成長法による Ge 結晶薄膜 / 絶縁基板の極低温形成 筑波大院数理物質 ¹ , 名大院工 ² , JST-CREST ³ ○沼田諒平 ^{1,2} , 都甲 薫 ¹ , 大谷直生 ¹ , 宇佐美徳隆 ^{2,3} , 末益 崇 ^{1,3}
	9:15 ~ 9:30	E18 ()	4.3 レーザ装置・材料 高効率高分解能角度分解光電子分光のための超高線り返し 5.9 eV 光源の開発 東大工 ¹ , 東大理 ² ○大間知潤子 ¹ , 吉岡孝高 ² , 五神 真 ^{1,2}
	10:45 ~ 11:00	D2 ()	15.2 II-VI 族結晶 インクジェット法による有機・無機ハイブリッド型 ZnSse 系紫外 APD 光検出器の開発 ~ 表面保護膜による長寿命化と集積化に向けて ~ 鳥取大院工 ¹ , 鳥取大工 ² ○井上亮一 ¹ , 稲垣雄介 ¹ , 茂津教行 ¹ , 藤本 健 ¹ , 田中健太 ² , 田末章男 ² , 阿部友紀 ¹ , 笠田洋文 ¹ , 安東孝止 ¹
	10:45 ~ 11:00	E15 ()	14.2 超薄膜・量子ナノ構造 (111)A 面上量子ドットを用いた量子もつれ光子対生成: 高忠実度化への制御 物性機構 ¹ , 北大電子研 ² , 学振 DC ³ ○中島秀朗 ^{1,2,3} , 黒田 隆 ¹ , 熊野英和 ² , 岡野高明 ¹ , 追田和彰 ¹ , 末宗幾夫 ²
	10:45 ~ 11:00	F8 ()	5.3 光制御 分極反転構造アレイアンテナ電極電気光学変調器を用いたミリ波帯空間多重無線信号の分離 阪大院基礎工 ¹ ○高武直弘 ¹ , 村田博司 ¹ , 岡村康行 ¹
10:45 ~ 11:00	F12 ()	3.7 近接場光学 EL スペクトルの評価によるホモ接合 Si-LiED 内のフォノンと電子正孔対との結合制御と評価 東大工 ¹ ○和田直樹 ¹ , 水島彩子 ¹ , 川添 忠 ¹ , 大津元一 ¹	
11:00 ~ 11:15	F7 ()	4.4 超高速・高強度レーザ 近赤外デュアルコム分光計の超広帯域化 産総研 ¹ , 慶大理工 ² ○大久保章 ^{1,2} , 岩間加奈 ^{1,2} , 稲場 肇 ¹ , 長谷川太郎 ² , 保坂一元 ¹ , 大苗 敦 ¹ , 佐々田博之 ² , 洪 鋒雷 ¹	
13:15 ~ 13:30	E2 ()	17.1 成長技術 SiC 上に成長したグラフェンのダメージフリー転写 NTT フォトニクス研 ¹ , NTT 物性基礎研 ² ○田邊真一 ¹ , 古川一暎 ² , 日比野浩樹 ²	
13:15 ~ 13:30	E10 ()	合同セッション K ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス α-InGaZnO の電子物性における水素の影響 奈良先端大 ¹ , CREST ² ○上岡義弘 ^{1,2} , Bermundo Juan Paolo ¹ , 山崎はるか ¹ , 浦川 哲 ¹ , 堀田昌宏 ^{1,2} , 浦岡行治 ^{1,2}	
13:30 ~ 13:45	D1 ()	11.1 基礎物性 BaTi ₂ Pn ₂ O (Pn = As, Sb, Bi) における超伝導と競合する秩序相 東大物性研 ¹ , 京大院工 ² , Columbia Univ. ³ , McMaster Univ. ⁴ , NIST ⁵ , CBPF ⁶ , Univ. of Delaware ⁷ ○矢島 健 ^{1,2} , 野崎保将 ² , 中野晃佑 ² , B. Frandsen ³ , L. Liu ³ , S. Cheung ³ , T. Goto ³ , Y. J. Uemura ³ , T. S. J. Munie ⁴ , T. Medina ⁴ , G. M. Luke ⁴ , J. Munevar ⁵ , 浜根大輔 ⁶ , C. M. Brown ^{6,7} , 陰山 洋 ²	
13:30 ~ 13:45	D8 ()	13.2 絶縁膜技術 High-k/Ge ゲートスタック界面特性向上に向けたゲート電極形成後熱処理条件の検討 阪大院工 ¹ , 原子力機構 ² ○田中亮平 ¹ , 秀島伊織 ¹ , 箕浦佑也 ¹ , 吉越章隆 ² , 寺岡有毅 ² , 細井卓治 ¹ , 志村孝功 ¹ , 渡部平司 ¹	
3/19 (水)	9:00 ~ 9:15	D5 ()	6.6 プローブ顕微鏡 高速液中 FM-AFM によるカルサイト結晶成長過程の原子分解能観察 金大院 ¹ , 金大バイオ AFM セ ² , ACT-C/JST ³ ○宮田一輝 ¹ , 浅川 雅 ² , 福岡剛士 ^{1,2,3}
	10:30 ~ 10:45	E6 ()	12.3 機能材料・萌芽的デバイス 光応答性銅鎖型液晶ブロック共重合体が示す動的配向挙動の考察 名大院工 ¹ , 名大 VBL ² , 東大院新領域 ³ ○佐野誠実 ¹ , 原 光生 ¹ , 永野修作 ² , 篠原裕也 ³ , 雨宮慶幸 ³ , 関 隆広 ¹
	11:30 ~ 11:45	E5 ()	12.1 作製・構造制御 赤外線レーザーによる熱交換有機半導体薄膜の配向制御と機能評価 神戸大院工 ¹ , 奈良先端大 ² ○鳥羽亜沙美 ¹ , 佐伯宏之 ² , 小柴康子 ¹ , 三崎雅裕 ¹ , 石田謙司 ¹ , 葛原大軌 ² , 山田容子 ² , 上田裕清 ¹
	13:00 ~ 13:15	E7 ()	10.2 スピントロクス・スピン流・回路・測定技術 電界誘起磁化ダイナミクスの実時間観測 東北大院研ナノ・スピン実験施設 ¹ , 電気通信大 ² , 東北大 CSIS ³ , 東北大 WPI-AIMR ⁴ ○金井 駿 ¹ , 仲谷崇伸 ² , 山ノ内路彦 ^{1,3} , 池田正二 ^{1,3} , 松倉文礼 ^{3,4} , 大野英男 ^{1,3,4}
	14:00 ~ 14:15	D3 ()	14.1 探索的材料物性 共有結合性半導体におけるチャネル構造とその電子物性 (バンドギャップと有効質量) との関係 東大院工 ¹ , マックスプランク ² ○松下雄一郎 ^{1,2} , 押山 淳 ¹
	14:00 ~ 14:15	D4 ()	11.2 薄膜, 厚膜, テープ作製プロセスおよび結晶成長 高ノ BaFe(As,P) 薄膜のヘテロエピタキシャル成長と等方的な磁束ピンニング特性 東大工 ¹ ○佐藤 光 ¹ , 平松秀典 ¹ , 神谷利夫 ¹ , 細野秀雄 ¹
	14:00 ~ 14:15	F6 ()	8.4 プラズマエッチング CH ₃ F ₂ プラズマエッチング時の SiO ₂ /Si 界面単位の生成 ソニー ○重蔵卓志 ¹ , 深沢正永 ¹ , 長畑和典 ¹ , 辰巳哲也 ¹
	15:45 ~ 16:00	D2 ()	16.1 基礎物性・評価 TiO ₂ 結晶化ガラスの光触媒特性評価 東大院工 ¹ , 京大化研 ² , 東北大多元研 ³ ○吉田和貴 ¹ , 正井博和 ² , 高橋儀宏 ¹ , 井原泉恵 ¹ , 藤原 巧 ¹ , 加藤英樹 ³ , 垣花眞人 ³
3/20 (木)	9:00 ~ 9:15	E6 ()	12.3 機能材料・萌芽的デバイス 高移動度有機材料 tris[4-(5-phenylthiophen-2-yl)phenyl]amine を用いた有機受光素子の特性改善に関する検討 阪大院工 ¹ , 琉球大 ² , 福井工大 ³ ○辻生翔一 ¹ , 梶井博武 ¹ , 景山 弘 ² , 城田靖彦 ³ , 大森 裕 ¹
	9:00 ~ 9:15	F2 ()	2.3 放射線応用・発生装置・新技術 長波長発光シンチレータの開発 東北大金研 ¹ , 東北大 NICHe ² , ロシア物理研 ³ ○黒澤俊介 ^{1,2} , 山路見広 ¹ , Vladimir Kochurikhin ³ , 鈴木 彬 ¹ , 横田有為 ² , 鎌田 圭 ² , 吉川 彰 ^{1,2}
	9:00 ~ 9:15	F8 ()	5.3 光制御 Bragg Reflector Waveguide Modulator toward High-Speed Operations and Low Power Consumption 東工大精研 ¹ , 東工大技術部 ² ○顧 曉冬 ¹ , 松谷亮宏 ² , 小山三三夫 ¹
	9:30 ~ 9:45	F7 ()	6.5 表面物理・真空 原子レベル構造の解明に基づいたチタン酸リチウム Li ₄ Ti ₅ O ₁₂ (111) 表面の電子状態解析 産総研 ¹ , ユビキタス ¹ , 立命館大・理工 ² ○橋田晃寛 ¹ , 田中真悟 ¹ , 松田太志 ² , 前田 泰 ¹ , 秋田知樹 ¹ , 城戸義明 ¹ , 香山正憲 ¹
	14:45 ~ 15:00	F4 ()	1.6 磁場応用 磁場中での磁場誘起形状記憶合金 Ni ₄₅ Mn ₄₅ In ₁₀ の構造特性 鹿児島大理 ¹ , 東北大金研 ² , 東北大工 ³ , 東北学院大 ⁴ ○アベ松賢一 ¹ , 梅津理恵 ² , 貝沼亮介 ³ , 鹿又 武 ⁴ , 渡辺和雄 ² , 小山佳一 ¹

会場欄の () 内の数字はプログラム掲載頁。